



2SB1590K (3CG1590K)

硅 PNP 半导体三极管/SILICON PNP TRANSISTOR

用途:用于一般功率放大。

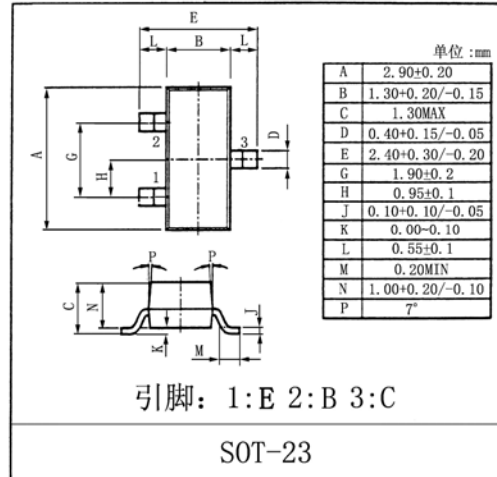
Purpose: General power amplifier applications.

特点: 低饱和压降, 大电流, 可与 2SD2444K (3DG2444K) 互补。

Features: Low $V_{CE(sat)}$, large current, complementary to 2SD2444K (3DG2444K).

极限参数/Absolute maximum ratings ($T_a=25^\circ\text{C}$)

| 参数符号 Symbol | 数值 Rating | 单位 Unit |
|----------------|--------------|------------------|
| V_{CB0} | -15 | V |
| V_{CE0} | -15 | V |
| V_{EB0} | -6.0 | V |
| I_C | -1.0 | A |
| I_{CM} | -3.0 | A |
| P_C | 200 | mW |
| T_j | 150 | $^\circ\text{C}$ |
| T_{stg} | -55~150 | $^\circ\text{C}$ |



电性能参数/Electrical characteristics ($T_a=25^\circ\text{C}$)

| 参数符号 Symbol | 测试条件 Test condition | 数值 Rating | | | 单位 Unit |
|----------------|---|--------------|------------|------------|---------------|
| | | 最小值 Min | 典型值 Typ | 最大值 Max | |
| V_{CB0} | $I_C=-50\mu\text{A}$ | -15 | | | V |
| V_{CE0} | $I_C=-1.0\text{mA}$ | -15 | | | V |
| V_{EB0} | $I_E=-50\mu\text{A}$ | -6.0 | | | V |
| I_{CB0} | $V_{CB}=-12\text{V}$ $I_E=0$ | | | -0.5 | μA |
| I_{EB0} | $V_{EB}=-5.0\text{V}$ $I_C=0$ | | | -0.5 | μA |
| $h_{FE(1)}$ | $V_{CE}=-2.0\text{V}$ $I_C=-0.5\text{A}$ | 120 | | 270 | |
| $h_{FE(2)}$ | $V_{CE}=-2.0\text{V}$ $I_C=-800\text{mA}$ | 80 | | | |
| $V_{CE(sat)}$ | $I_C=-0.4\text{A}$ $I_B=-20\text{mA}$ | | | -0.3 | V |
| f_T | $V_{CE}=-2.0\text{V}$ $I_E=50\text{mA}$ $f=100\text{MHz}$ | | 200 | | MHz |
| C_{ob} | $V_{CB}=-10\text{V}$ $I_E=0\text{A}$ $f=1.0\text{MHz}$ | | 15 | | pF |

$h_{FE(1)}$ 分档、印章/ $h_{FE(1)}$ Classifications、Marking:

| | |
|---|---------|
| $h_{FE(1)}$ 分档/ $h_{FE(1)}$ Classifications | Q |
| $h_{FE(1)}$ 范围/ $h_{FE(1)}$ Range | 120~270 |
| 印章/Marking | HBKQ |

